

## Литература

- [1] P. H. Lee, M. L. Skolnik. IEEE J. Quant. Electron., QE-3, № 1, 609, 1967.
- [2] C. Meyer, P. Pinson, C. Rossetti, P. Rachewitz. Canad. J. Phys., 47, 2565, 1969.
- [3] Ю. Н. Громов, В. П. Тычинский, Н. Ш. Хайкин, В. П. Харьков. ПТЭ, № 3, 183, 1971.
- [4] M. A. Kovacs, G. W. Flinn, A. Javan. Appl. Phys. Lett., 8, 62, 1966.
- [5] А. Л. Микаэлян, А. Л. Коровицын, Л. В. Наумова, С. М. Арсеньева. Радиотехника и электроника, 14, 411, 1969.
- [6] G. W. Flin, L. O. Kockeg, A. Javan, M. A. Kovacs, C. K. Rhoudes. IEEE J. Quant. Electron., QE-2, № 9, 378, 1966 (Перевод сб. «Газовые лазеры», ред. Н. Н. Соболев. Изд. «Мир», 1968).
- [7] P. K. Cheo. J. Appl. Phys., 38, 3563, 1967.
- [8] P. K. Cheo, R. L. Abrams. Appl. Phys. Lett., 14, 47, 1969.

Поступило в Редакцию 20 июня 1972 г.

УДК 539.184 : 548.0

## О СПИНОВОЙ ПАМЯТИ $\text{Eu}^{2+}$ В $\text{CaF}_2$

*A. B. Комаров и С. М. Рябченко*

Изучение магнитного циркулярного дихроизма люминесценции (МЦДЛ)  $\text{Eu}^{2+}$  в  $\text{CaF}_2$  на линии 4130 Å [1] позволило установить, что возбужденное состояние  ${}^4\Gamma_8$  характеризуется распределением населенностей между спиновыми подуровнями, соответствующим более высокой спиновой температуре  $T_S$ , чем температура решетки. Замечено также, что величина  $T_S$  в  ${}^4\Gamma_8$ -состоянии изменяется при различных типах поляризации возбуждающего света  $\lambda = 3650 \text{ Å}$ .

Полученные результаты согласуются с работой [2] по эффекту Зеемана люминесцентной линии 4130 Å, однако противоречат данным о времени  $T_1$  спин-решеточной релаксации в  ${}^4\Gamma_8$ -состоянии, приведенным в [3]. Согласно [3], спиновая температура  ${}^4\Gamma_8$ -состояния должна практически соответствовать температуре решетки независимо от способа возбуждения, поскольку  $T_1$  существенно меньше времени жизни возбужденного состояния.

Известно, что люминесцентная линия 4130 Å соответствует резонансному переходу  ${}^4\Gamma_8 \leftrightarrow {}^8S_{7/2}$ , четко проявляющемуся в поглощении. Поэтому явления резонансного перепоглощения помешали провести более точные измерения  $T_S$  в работе [1].

В связи с этим нами проведены измерения МЦДЛ на широкой колебательной полосе  $\lambda = 4200 \text{ Å}$ , соответствующей переходам с подуровней  ${}^4\Gamma_8$ -состояния на колебательные подуровни основного состояния. Измерения проводились при  $T = 1.7^\circ \text{ K}$  в магнитных полях до 4000 э. Применялась методика, описанная в [1], с добавлением врачающейся фазовой пластинки в четверть длины волны. Сигнал на удвоенной частоте вращения пластиинки, который измерялся регистрирующей системой, пропорционален при этом

$$\frac{I_{H \neq 0}^{\sigma+} - I_{H=0}^{\sigma-}}{I_{H=0}^{\sigma+} + I_{H=0}^{\sigma-}} = \frac{\Delta I_{H \neq 0}^{\sigma+} - \Delta I_{H=0}^{\sigma-}}{I_{H=0}^{\sigma+} + I_{H=0}^{\sigma-}} = \\ = \frac{\sum_{ij} W_{ij}^{\sigma+} [N'_{i(H \neq 0)} - N'_{i(H=0)}] - \sum_{ij} W_{ij}^{\sigma-} [N'_{i(H \neq 0)} - N'_{i(H=0)}]}{\sum_{ij} W_{ij}^{\sigma} N'_{i(H=0)}}, \quad (1)$$

где  $\Delta I_{H \neq 0}^{\sigma\pm} = I_{H \neq 0}^{\sigma\pm} - I_{H=0}^{\sigma\pm}$  — изменение интенсивности  $\sigma\pm$ -поляризованной компоненты люминесценции  $\lambda = 4200 \text{ Å}$  при увеличении магнитного поля от нуля до величины  $H \neq 0$ ,  $W_{ij}$  — вероятности зеемановских переходов люминесценции  $\lambda = 4200 \text{ Å}$  с  $i$ -го уровня  ${}^4\Gamma_8$ -состояния на электронно-колебательный подуровень, образованный комбинацией колебания с  $j$ -м спиновым подуровнем  ${}^8S_{7/2}$ -состояния,  $N'_{i(H=0)}$  и  $N'_{i(H \neq 0)}$  — населенности  $i$ -х магнитных подуровней  ${}^4\Gamma_8$ -состояния при  $H=0$  и  $H \neq 0$  соответственно.

Учитывая полносимметричный характер данных колебаний, мы предположили, что вероятности переходов  $W_{ij}$  для зеемановских компонент электронно-колебательного перехода люминесценции пропорциональны соответствующим вероятностям для чисто электронного перехода, приведенным в [4]. Населенности вычислялись для разных значений  $T_S$  в  ${}^4\Gamma_8$ -состоянии:  $N'_{i(H \neq 0)} = e^{-E_i/kT_S} / \sum_i N'_i / \sum_i e^{-E_i/kT_S}$ . Значе-

ния  $E_i$  вычислялись с помощью спин-гамильтониана, найденного для  ${}^4G_8$ -состояния в работе [5]. Естественно, предположение о Больцмановском распределении населенности в системе подуровней возбужденного состояния не является достаточно обоснованным. Поэтому, говоря о спиновой температуре возбужденного состояния, мы здесь, так же как и в [1], имеем в виду эффективную спиновую температуру, при которой расчетные различия в интенсивностях поляризованного по различным направлениям круга света люминесценции (сигнал МЦДЛ) соответствуют этим же различиям при реальном распределении населенности. Проводя вычисления по формуле (1) для различных значений  $T_S$ , мы определяли эффективную спиновую температуру  ${}^4G_8$ -состояния, сравнивая величину экспериментального сигнала МЦДЛ с расчетом.

На рис. 1 приведены зависимости сигнала МЦДЛ от величины магнитного поля ( $H \parallel [100]$ ), полученные при различных способах возбуждения люминесценции. Кривая I

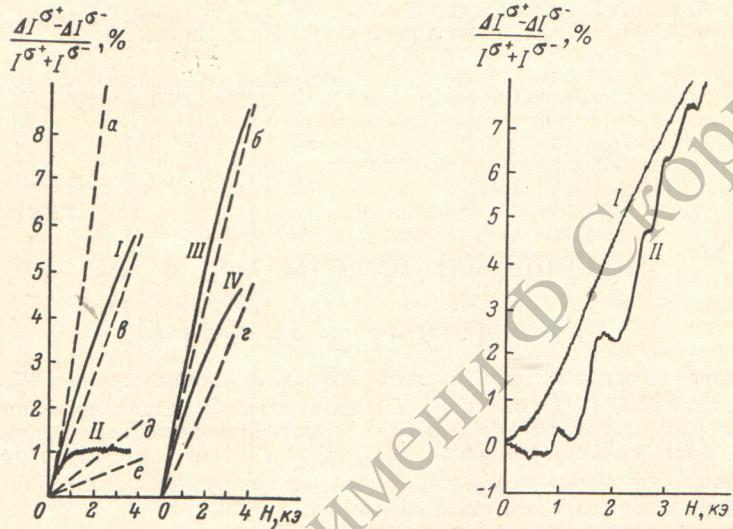


Рис. 1. Зависимость сигнала МЦДЛ колебательной полосы люминесценции  $\lambda = 4200 \text{ \AA}$   $\text{Eu}^{2+}$  в  $\text{CaF}_2$  ( $T = 1.7^\circ \text{K}$ ) от магнитного поля.

I, II — при возбуждении  $\sigma$ - и  $\pi$ -поляризованным светом соответственно, когда  $\lambda_{\text{возб.}} = 3850 \text{ \AA}$ . III, IV — при возбуждении  $\sigma$ - и  $\pi$ -поляризованным светом соответственно, когда  $\lambda_{\text{возб.}} = 4040 \text{ \AA}$ . Рассчитанная зависимость при  $T_S, {}^\circ\text{K}$ : a — 1.7, б — 3.6, в — 6, г — 6.6, д — 20, е — 40.

Рис. 2. Зависимость сигнала МЦДЛ колебательной полосы люминесценции  $\lambda = 4200 \text{ \AA}$   $\text{Eu}^{2+}$  в  $\text{CaF}_2$  при  $\sigma$ -возбуждении  $\lambda_{\text{возб.}} = 4040 \text{ \AA}$  от магнитного поля ( $H \parallel [100]$ ,  $T = 1.7^\circ \text{K}$ ). I — без СВЧ подсветки, II — с СВЧ подсветкой ( $f = 9300 \text{ МГц}$ ).

на рис. 1 соответствует  $\sigma$ -возбуждающему свету с длиной волны  $3850 \text{ \AA}$ ,  ${}^4G_8$ -состояние в этом случае характеризуется  $T_S \approx 6^\circ \text{K}$ . Для  $\pi$ -возбуждения этой же длиной волн спиновая температура плавно увеличивается с ростом  $H$  и достигает  $T_S \approx 40^\circ \text{K}$  при  $H = 4000$  эрст. (рис. 1, III).

Приведенные значения спиновой температуры  ${}^4G_8$ -состояния удовлетворительно согласуются с результатами для МЦДЛ резонансной люминесцентной линии  $4130 \text{ \AA}$ , полученными в [1]. Когда длина волны возбуждающего света равна  $4040 \text{ \AA}$ , в возбужденном состоянии реализуется более низкая спиновая температура: для  $\sigma$ -поляризации возбуждения  $T_S \approx 3.6^\circ \text{K}$ , а для  $\pi$ -света  $T_S \approx 6-7^\circ \text{K}$  (кривые III и IV соответственно на рис. 1).

Следует отметить, что кривая (e) на рис. 1, рассчитанная для  $T_S = 40^\circ \text{K}$ , заметно отличается от соответствующей экспериментальной (рис. 1, II). Мы предположили в данном случае, что значение  $T_S$  в  ${}^4G_8$ -состоянии изменяется с изменением величины магнитного поля. Возможно также, что в этом состоянии реализуется не Больцмановское распределение, которое нельзя описывать эффективной спиновой температурой. Во всяком случае можно сказать, что указанное различие определенным образом связано с механизмом спиновой памяти в описываемой системе.

На рис. 2 приведена зависимость сигнала МЦДЛ от величины  $H$  при  $\sigma$ -возбуждении  $\lambda = 4040 \text{ \AA}$  и одновременной СВЧ-подсветке на образец  $H \parallel [100]$ . На кривой появились провалы, соответствующие ЭПР основного  ${}^8S_{1/2}$ -состояния, аналогичные полученным в [1, 6]. Характерным является то, что ЭПР-переходы в  ${}^8S_{1/2}$ -состоянии приводят

к уменьшению сигнала МЦДЛ, т. е. повышению спиновой температуры в  ${}^4G_8$ -состоянии. На записи, проведенной при  $\pi$ -возбуждении 3650 Å линией ртути в пределах экспериментальной ошибки, провалов заметить не удалось, что, очевидно, связано с высокой спиновой температурой в  ${}^4G_8$ -состоянии.

Проявление ЭПР основного состояния в электронно-колебательной люминесценции может быть связано со спиновой памятью либо с изменением спиновой температуры из-за влияния перепоглощения на эффективное время жизни отдельных зеемановских компонент  ${}^4G_8$ -состояния. В последнем случае ЭПР основного состояния проявлялся бы независимо от спиновой температуры  ${}^4G_8$ -состояния. Наблюдаемый эффект не может быть связан с кросс-релаксацией между ионами в основном и возбужденном состояниях, так как сильная зависимость спиновой температуры  ${}^4G_8$ -состояния от способа возбуждения указывает на отсутствие такой кросс-релаксации в системе.

Подобным путем, по МЦДЛ колебательной полосы люминесценции  $\lambda=4200$  Å были получены резонансные спектры ЭПР и для других ориентаций кристалла в магнитном поле. Зарегистрированные спектры в основном совпадали со спектрами ЭПР  ${}^8S_{7/2}$ -состояния, полученными по резонансной линии 4130 Å [1], кроме заметного различия в отношении интенсивностей запрещенных и разрешенных переходов ЭПР. Последнее, очевидно, связано с различием между механизмом спиновой памяти и механизмом резонансного перепоглощения, ответственного за проявление ЭПР основного состояния в случае [1].

На основании полученных результатов можно считать установленным, что, несмотря на то что заселение  ${}^4G_8$ -состояния осуществляется возбуждением в высоко лежащие состояния с последующей безызлучательной релаксацией, распределение населенности в  ${}^4G_8$ -состоянии связано с распределением населенности в  ${}^8S_{7/2}$ -состоянии и правилами отбора для возбуждающего света, т. е. с явлением спиновой памяти. Остается не ясным противоречие с данными работы [3] по времени  $T_1$  спин-решеточной релаксации в состоянии  ${}^4G_8$ .

#### Литература

- [1] А. В. Комаров, С. М. Рябченко. Опт. и спектр., 35, 1973.
- [2] Б. П. Захарчина, А. Я. Рыскин, Ю. А. Степанов. Письма в ЖЭТФ, 10, 517, 1969.
- [3] L. L. Chase. Phys. Rev., B2, 2308, 1970.
- [4] М. В. Еремин, Б. П. Захарчина, А. Я. Рыскин, Ю. А. Степанов. ФТТ, 13, 1128, 1971.
- [5] Б. П. Захарчина, И. Б. Рusanov, А. Я. Рыскин. Опт. и спектр., 18, 999, 1965.
- [6] А. В. Комаров, С. М. Рябченко. ПТЭ, 4, 201, 1971.

Поступило в Редакцию 5 июля 1972 г.

УДК 535.375

## К СТАТИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ВЫНУЖДЕННОГО РАССЕЯНИЯ МАНДЕЛЬШТАМА—БРИЛЛЮЭНА

В. Ф. Бойцов и С. Г. Слюсарев

1. Приводятся результаты расчетов свойств оптического параметрического усилителя. Усилитель состоит из трех квантовых полевых мод  $M_j$ , выделенных резонатором, две из которых  $M_1$  и  $M_3$  обладают потерями, и классической монохроматической моды накачки  $M_\omega$  с постоянной амплитудой. Условия временного синхронизма, которые предполагаются выполненными достаточно точно, имеют вид  $\omega = \omega_1 + \omega_3 = \omega_2 - \omega_3$ .

Примерами параметрического усиления могут служить частотное расщепление интенсивных световых пучков в нелинейных диэлектрических средах, а также вынужденное рассеяние Рамана—Ландсберга и Мандельштама—Бриллюэна.

2. Модель усилителя основана на теории Луиселла, Ярива и Зигмана [1] и рассмотрена в ряде работ [2, 3]. Потери в модах  $M_1$  и  $M_3$  вводятся квантовомеханически с помощью процедуры, предложенной в [4]: возбужденные моды затухают в результате связи их с континуумом «резервуарных» осцилляторов, которые включены в гамильтониан системы. Сам гамильтониан при этом описывает замкнутую систему и таким образом остается эрмитовым. Квантовомеханическое рассмотрение процесса параметрического усиления дает возможность описать эволюцию системы при различных начальных условиях, определить для каждой моды среднее число фотонов и их дисперсию в зависимости от времени, вычислить статистику фотонов и т. д. [2].

Новым по сравнению с работами [3] в данном сообщении является включение в модель усилителя моды  $M_2$ , которая связана с модой  $M_3$  полем накачки через нелинейность среды. При определенных условиях (11) появление моды  $M_2$  приводит к но-